

# Silicon Diode

## **1N4383**

200V / 1A

# DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

# 1 N 4383... 1 N 4586

## Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Nennstrom	1 A
period. Spitzensperrspannung	200...1000 V

Glasgehäuse JEDEC DO-29  
56 A 2 nach DIN 41 883  
Gewicht ca. 0,4 g  
Maße in mm



## Grenzwerte

Typ	periodische Spitzensperrspannung $U_{RRM}$ V		
1 N 4383	200		
1 N 4384	400		
1 N 4385	600		
1 N 4585	800		
1 N 4586	1000		
periodischer Spitzenstrom bei $\theta < 40^\circ, f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	10	A
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	50	A
Verlustleistung in Sperrichtung bei $t < 20 \mu\text{s}$	$P_{RSM}$	1	kW
bei $t < 100 \mu\text{s}$	$P_{RSM}$	0,5	kW
Sperrschichttemperatur	$T_j$	175	$^\circ\text{C}$
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich	$T_U, T_S$	-65...+175	$^\circ\text{C}$

# 1 N 4383... 1 N 4586

## Kennwerte

Nennstrom in Einwertschaltung  
mit Widerstandslast  
bei  $T_U = -65...+100\text{ °C}$   
bei  $T_U = 150\text{ °C}$

$I_{FAV}$  1 A  
 $I_{FAV}$  0,3 A

Durchlaßspannung  
bei  $I_F = 1\text{ A}$ ,  $T_J = 25\text{ °C}$

$U_F$  <1 V

Sperrstrom  
bei  $U_{RRM}$ ,  $T_U = 25\text{ °C}$

$I_R$  <10  $\mu\text{A}$

Wärmewiderstand  
Sperrschicht - umgebende Luft

$R_{thU}$  <80 K/W

## Durchlaßkennlinien

zulässiger Richtstrom in Einwertschaltung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

